

Ю. В. КОРНЕВ, Д. И. СЕМЕНЦОВ

ТЕОРИЯ ФЕРРОМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА В ТОНКОЙ  
МАГНИТНОЙ ПЛЕНКЕ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ  
АНИЗОТРОПИЕЙ

(Представлено академиком Г. В. Курдюмовым 20 IV 1970)

В работах Смита (<sup>1, 2</sup>) было вначале предположено, а затем и экспериментально доказано, что в тонкой ферромагнитной пленке при определенных условиях ее формирования могут образовываться участки с отрицательными значениями поля анизотропии. В таких участках легкая ось ориентируется перпендикулярно легкой оси участков с положительным полем анизотропии. Для некоторых образцов отношение объемов областей с положительной и отрицательной анизотропией было близко к единице.

В данной работе показано, что наличие у пленок областей с положительным и отрицательным полем анизотропии приводит к двум ветвям в спектре частот ферромагнитного резонанса (ф.м.р.) при любой ориентации внешнего поля — низкочастотной и высокочастотной. Для этого использовалась модель пленки, состоящая из магнитно не взаимодействующих микроучастков (блоков), обоснование которой (для пленок с положительным полем анизотропии) дано в работах А. Г. Лесника (<sup>3, 4</sup>). Пленка предполагалась сформированной так, что каждый блок с положительным полем анизотропии имеет ближайшими соседями блоки с отрицательным полем анизотропии, а каждый блок с отрицательной анизотропией окружен блоками с положительной анизотропией. Магнитное состояние каждого блока характеризуется локальными параметрами — амплитудой поля анизотропии  $H_{kl}$  и углом его наклона  $\beta_l$  к средней оси анизотропии соответствующей группы блоков. Считается, что эти параметры распределены в каждой группе блоков по гауссовому закону. Любое магнитное свойство пленки, зависящее от дисперсии анизотропии, находится в этой модели путем усреднения локального свойства по всем значениям выбранных параметров.

1. Согласно выбранной модели, энергия пленки при наличии внешних полей, ориентированных в плоскости пленки (рис. 1), определяется следующим образом:

$$E = \sum_{\{f\}} E_f + \sum_{\{g\}} E_g, \quad E_l = -N^{(e)}M_l + 1/2 M_l H_{kl} \sin^2(\varphi_l - \beta_l) \quad (l=f, g), \quad (1)$$

где  $N^{(e)}$  — внешнее магнитное поле,  $H_{kf} > 0$  и  $H_{kg} < 0$  — поля локальной одноосной анизотропии блоков  $\{f\}$  и  $\{g\}$ , углы  $\beta_f$  и  $\pi/2 + \beta_g$  задают направления локальных легких осей блоков с положительной и отрицательной анизотропией.

Из условий минимальности энергии (1)  $\frac{\partial E}{\partial \varphi_l} \Big|_{\varphi_l = \varphi_{l0}} = 0$  и  $\frac{\partial^2 E}{\partial \varphi_l^2} \Big|_{\varphi_l = \varphi_{l0}} > 0$  определяются равновесные направления векторов намагниченности.

В зависимости от направления и величины приложенного поля имеем:

а)  $H_{\parallel} = H, H_{\perp} = 0$ , т. е. внешнее поле приложено вдоль средней легкой оси блоков  $\{f\}$ . Малые равновесные углы областей  $\{f\}$  при всех полях связаны с направлением локальных осей соотношением  $\varphi_{f0} \delta_f \pm \beta_f$ , где  $\delta_f \pm =$

$= H_{kl} / (H \pm H_{kl})$ ; равновесные углы областей  $\{g\}$  в разных полях удовлетворяют разным соотношениям, так

$$\varphi_{g0} = \delta_g^+ \beta_g \text{ при } H > H_{kg} \cos 2(1 - \delta_g^+) \beta_g / \cos \beta_g \delta_g^+, \quad (2)$$

а связь  $\tilde{\varphi}_{g0} = -\beta_g - H / H_{kg}$  реализуется в полях  $H < H_{kg} / \sqrt{2 - \cos \beta_g}$ , где  $\tilde{\varphi}_{f0} = \pi / 2 - \varphi_{f0}$  — малый угол.

б)  $H_{\parallel} = 0, H_{\perp} = H$ , т. е. внешнее поле приложено вдоль средней легкой оси областей  $\{g\}$ . Аналогично предыдущему случаю можно показать,

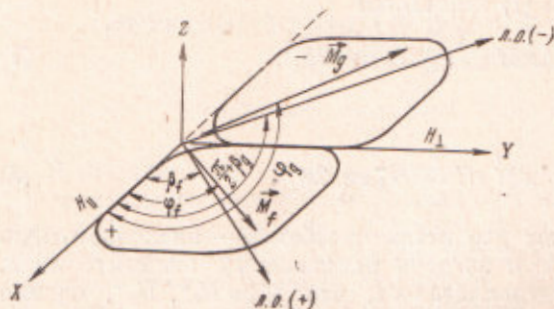


Рис. 1

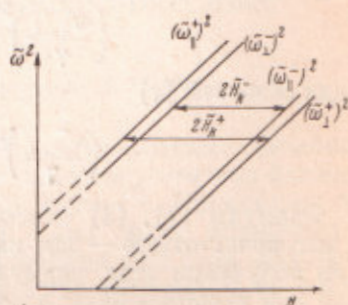


Рис. 2

Рис. 1. Направление локальных осей (л.о.) и векторов намагниченности в блоках

Рис. 2. Зависимость квадрата резонансных частот пленки от внешнего поля ( $\tilde{\omega}^2 = \omega^2 / 4\pi M \gamma^2, H_{k\pm} = H_{k\pm} \cos 2\beta_{\pm}$ )

что для малых углов областей  $\{g\}$  соотношение  $\tilde{\varphi}_{g0} = \delta_g^- \beta_g$  выполняется, в любых по величине полях, тогда как для блоков  $\{f\}$  имеем

$$\tilde{\varphi}_{f0} = \delta_f^- \beta_f \text{ при } H > H_{kf} \cos 2(1 + \delta_f^-) \beta_f / \cos \beta_f \delta_f^-, \quad (3)$$

а  $\varphi_{f0} = \beta_f + H / H_{kf}$  реализуется в полях  $H < H_{kf} / \sqrt{2 - \cos \beta_f}$ .

2. Вопрос о резонансном поведении системы исследовался с помощью уравнений Ландау — Лифшица, записанных в сферических координатах. Так как рассматривается модель невзаимодействующих блоков, то уравнения, описывающие поведение каждой из групп, решаются независимо друг от друга. В зависимости от направления и величины приложенных полей выражения для резонансных частот для каждой из групп блоков получаются следующими:

$$(\omega_l / \gamma)^2 = 4\pi M_l [H \cos \delta_l^{\pm} \beta_l \pm H_{kl} \cos 2(1 \mp \delta_l^{\pm}) \beta_l] \quad (l = f, g). \quad (4)$$

Если  $H_{\parallel} = H, H_{\perp} = h_{\sim}$ , причем с.в.ч. поле  $h_{\sim} \ll H$ , то в (4) учитывается верхний знак. Полученная формула в этом случае верна для областей  $\{f\}$  при любых значениях подмагничивающего поля, а для областей  $\{g\}$  только при выполнении неравенства (2). Если же поле  $H \gg H_{kl}$ , то  $\delta_l^{\pm} \rightarrow 0$ , и формула (4) переписывается так:

$$(\omega_l / \gamma)^2 = 4\pi M_l (H \pm H_{kl} \cos 2\beta_l) \quad (l = f, g). \quad (5)$$

В полях  $H < H_{kl} / \sqrt{2 - \cos \beta_l}$  области  $\{g\}$  в случае  $H_{\parallel} = H$  и области  $\{f\}$  в случае  $H_{\perp} = H$  не резонируют, так как не выполняются условия резонанса — отсутствует составляющая намагниченности, перпендикулярная высокочастотному полю  $h_{\sim}$ .

3. Полученные формулы дают сведения о локальных характеристиках тонкой пленки. Положение резонансных линий для пленки в целом находится усреднением полученных выражений по всем значениям соответствующих параметров. Следуя экспериментальным данным, распределение легких осей в каждой группе блоков подчинялось гауссовому закону

$$P(\beta_l) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\beta_{\pm}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\beta_l}{\beta_{\pm}}\right)^2\right] \quad (l = f, g), \quad (6)$$

где  $\beta_{\pm}$  — среднеквадратичное отклонение от средней оси анизотропии соответствующей группы блоков. Дисперсию амплитуды поля анизотропии в каждой группе для простоты считаем отсутствующей, т. е. значение поля анизотропии одинаково во всех блоках  $\{f\}$  и равно  $H_k^+$ , а в блоках  $\{g\}$  равно  $H_k^-$ . Плотность намагниченности полагаем по всей пленке одинаковой, т. е.  $M_f = M_g = M$ . С учетом этих предположений после усреднения выражение (5) для областей  $\{f\}$  запишется

$$\left(\frac{\omega_{\parallel, \perp}^+}{\gamma}\right)^2 = 4\pi M (H \pm H_k^+ \cos 2\beta_+), \quad (7)$$

а для областей  $\{g\}$

$$\left(\frac{\omega_{\parallel, \perp}^-}{\gamma}\right)^2 = 4\pi M (H \mp H_k^- \cos 2\beta_-). \quad (8)$$

Формулы (7), (8) описывают две ветви колебаний — низкочастотную и высокочастотную — для каждого из двух направлений внешнего поля. При получении этих формул предполагалось, что  $H \gg H_k^+, H_k^-$ , однако уже при внешнем поле, в несколько раз превышающем поле анизотропии блоков, они являются хорошим приближением точных соотношений. На рис. 2 показана часть спектра резонансных частот, соответствующая этим полям. Чтобы получить спектр для малых полей, необходимо усреднить (4), что ведет к значительным математическим осложнениям, так как в этом случае требуется учет связей (2), (3), зависящих от поля. Ясно, что дисперсия легких осей приводит к нарушению на этом участке линейной зависимости квадрата резонансной частоты от внешнего поля.

Результаты, полученные в настоящей работе, характерны только для пленок, имеющих блочную структуру с положительной и отрицательной анизотропией. В работе не учитывалось взаимодействие между блоками, которое может иметь место в реальных пленках и приводить к сдвигу резонансных частот. Спектр, полученный в данной работе, в тонких магнитных пленках пока экспериментально не обнаружен, что может объясняться спецификой получения таких пленок и отсутствием эксперимента по резонансу на них.

Московское высшее техническое училище  
им. Н. Э. Баумана

Поступило  
8 IV 1970

#### ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- <sup>1</sup> D. O. Smith, J. Appl. Phys., 32, 70 (1961). <sup>2</sup> D. O. Smith, Appl. Phys. Lett., 2, 191 (1963). <sup>3</sup> А. Г. Лесник, Физ. мет. и металловед., в. 6, 27 (1969). <sup>4</sup> А. Г. Лесник, Там же, в. 1, 28 (1969).